

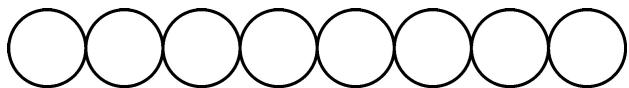


Series GEFH1/5



SET ~ 3

रोल नं.
Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code **55/5/3**

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं।
Please check that this question paper contains 35 questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.





सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड-क, ख, ग, घ तथा ङ।
- (iii) खण्ड-क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड-ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रकार-1 के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड-ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रकार-2 के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड-घ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड-ड में प्रश्न संख्या 34 तथा 35 केस आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड-ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड-ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड-घ के 3 प्रश्नों में तथा खण्ड-ड के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान } (m_e) = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल}$$

$$\text{बोल्टज्जमान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and follow them :

- (i) This question paper contains 35 questions. All questions are compulsory.
- (ii) Question paper is divided into FIVE sections – Section A, B, C, D and E.
- (iii) In section – A : question number 1 to 18 are Multiple Choice (MCQ) type questions carrying 1 mark each.
- (iv) In section – B : question number 19 to 25 are Short Answer-1 (SA-1) type questions carrying 2 marks each.
- (v) In section – C : question number 26 to 30 are Short Answer-2 (SA-2) type questions carrying 3 marks each.
- (vi) In section – D : question number 31 to 33 are Long Answer (LA) type questions carrying 5 marks each.
- (vii) In section – E : question number 34 and 35 are case-based questions carrying 4 marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section – B, 2 questions in Section – C, 3 questions in Section – D and 2 questions in Section – E.
- (ix) Use of calculators is NOT allowed.

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (m}_e\text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



खण्ड - क



SECTION – A



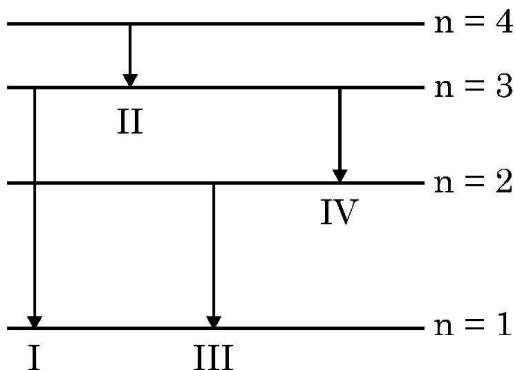
7. किसी फोटॉन की ऊर्जा, वेग और आवृत्ति को क्रमशः E, c और ν द्वारा निरूपित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक इसकी तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है ? 1
 (A) $\frac{h\nu}{c^2}$ (B) $h\nu$
 (C) $\frac{hc}{E}$ (D) $\frac{h\nu}{c}$

8. द्रव्यमान संख्या 64 और 125 के दो नाभिकों के नाभिकीय घनत्वों का अनुपात होता है 1
 (A) $\frac{64}{125}$ (B) $\frac{4}{5}$
 (C) $\frac{5}{4}$ (D) 1

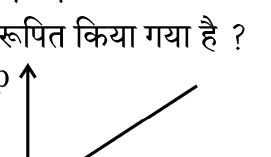
9. किसी इलेक्ट्रॉन को कक्ष ताप पर सिलिकॉन में वर्जित बैण्ड से कूदान के लिए लगभग कितनी ऊर्जा चाहिए ? 1
 (A) 0.01 eV (B) 0.05 eV
 (C) 0.7 eV (D) 1.1 eV

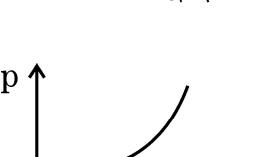
10. हाइड्रोजन परमाणु के बोर-मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन के चार ऊर्जा-स्तरों को आरेख में दर्शाया गया है।
उस संक्रमण को पहचानिए जिसमें उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा उच्चतम होगी। 1

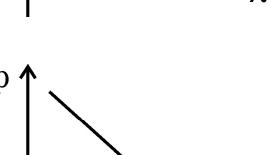
 (A) I (B) II
 (C) III (D) IV



11. नीचे दिए गए कौन से ग्राफ में किसी कण के संवेग के विचरण को उससे संबद्ध देखा जाएगा ?

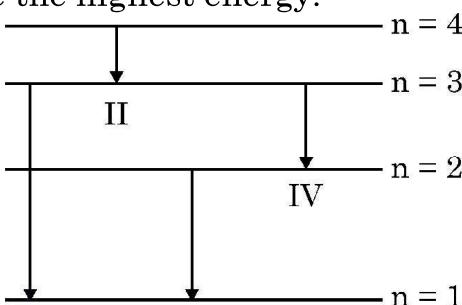
(A) 

(B) 

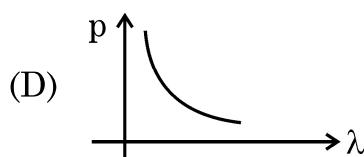
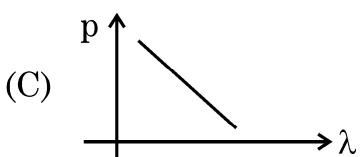
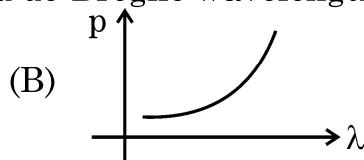
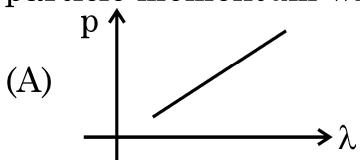
(C) 

(D) 





11. Which of the following graphs correctly represents the variation of a particle momentum with its associated de-Broglie wavelength ? 1









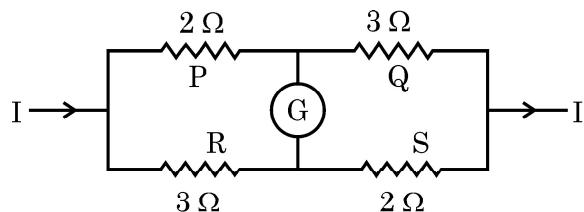
नोट : प्रश्न संख्या 16 से 18 में दो कथन दिए गए हैं – एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) लेबल किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तरों का नीचे दिए गए कोड (a), (b), (c) और (d) में से चयन कीजिए :

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) अभिकथन (A) सत्य हैं और कारण (R) असत्य है।
- (D) अभिकथन (A) असत्य हैं और कारण (R) भी असत्य है।

16. **अभिकथन (A) :** किसी नैज अर्धचालक के प्रतिरोध में उसके ताप में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। 1

कारण (R) : किसी नैज अर्धचालक में ताप में वृद्धि होने पर चालन इलेक्ट्रॉनों और विवरों दोनों की संख्या में वृद्धि होती है।

17. **अभिकथन (A) :** दिया गया आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को नहीं दर्शाता है। 1



कारण (R) : किसी संतुलित सेतु के लिए गैल्वैनोमीटर से लघु धारा प्रवाहित होनी चाहिए।

18. **अभिकथन (A) :** जब किसी धारावाही पाश का तल चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् होता है तो उस पर कार्यरत विक्षेपक बल-आधूर्ण शून्य होता है। 1

कारण (R) : किसी चुम्बकीय क्षेत्र \vec{B} में चुम्बकीय आधूर्ण \vec{m} के पाश पर कार्यरत विक्षेपक बल-आधूर्ण \vec{m} और \vec{B} का अदिश गुणनफल (बिन्दु गुणनफल) होता है।



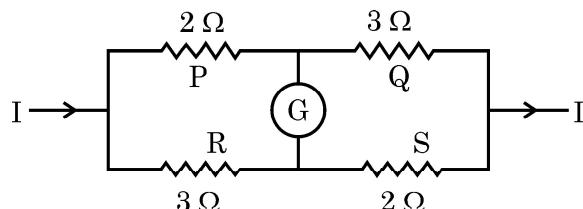
Note : In question number **16** to **18** two statements are given – one labelled **Assertion (A)** and the other labelled **Reason (R)**. Select the correct answer to these questions from the codes **(a), (b), (c) and (d)** as given below :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and (R) is NOT the correct explanation of (A).
- (C) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.

16. Assertion (A) : The resistance of an intrinsic semiconductor decreases with increase in its temperature. 1

Reason (R) : The number of conduction electrons as well as hole increase in an intrinsic semiconductor with rise in its temperature.

17. Assertion (A) : The given figure does not show a balanced Wheatstone bridge. 1



Reason (R) : For a balanced bridge small current should flow through the galvanometer.

18. Assertion (A) : The deflecting torque acting on a current carrying loop is zero when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. 1

Reason (R) : The deflecting torque acting on a loop of magnetic moment \vec{m} in a magnetic field \vec{B} is given by the dot product of \vec{m} and \vec{B} .



खण्ड – ख

19. विभिन्न तीव्रताओं I_1 और I_2 ($I_1 > I_2$) परन्तु समान आवृत्तियों के दो प्रकाश पुन्जों के एनोड विभव को फलन मानकर प्रकाश विद्युत धारा के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए। इसके महत्वपूर्ण लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 2

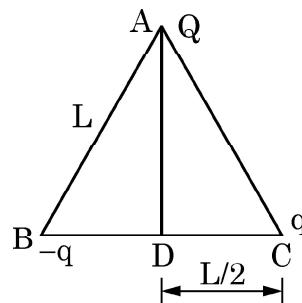
20. (a) किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य किस प्रकार प्रभावित होती है, जब
 (i) इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है ? तथा
 (ii) त्वरक विभव में वृद्धि होती है ?
 अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 2

अथवा

- (b) किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पृष्ठ के लिए निरोधी विभव में किस प्रकार परिवर्तन होगा यदि
 (i) आपतित विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि कर दी जाए ? और
 (ii) आपतित विकिरण की तीव्रता कम कर दी जाए ?
 अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

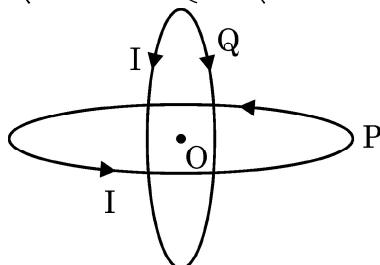
21. विद्युतचुम्बकीय तरंगों किस प्रकार उत्पन्न होती हैं ? इनके दो अभिलक्षण लिखिए। 2

22. आरेख में दर्शाए अनुसार भुजा L के किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर तीन बिन्दु आवेश Q , q और $-q$ स्थित हैं। 2



- (i) इस व्यवस्था की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है ? और
 (ii) बिन्दु D पर विभव क्या है ?

23. (a) आरेख में दर्शाए अनुसार त्रिज्या R के दो सर्वसम वृत्ताकार पाश P और Q जिनसे धारा I प्रवाहित हो रही है लम्बवत् तलों में इस प्रकार रखे हैं कि इनका उभयनिष्ठ केन्द्र O है।



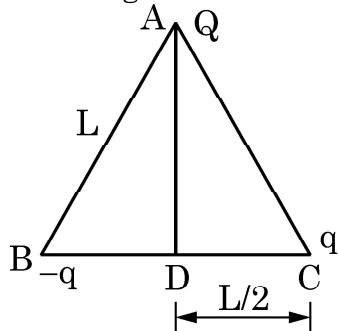
बिन्दु O पर नेट चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। 2

अथवा



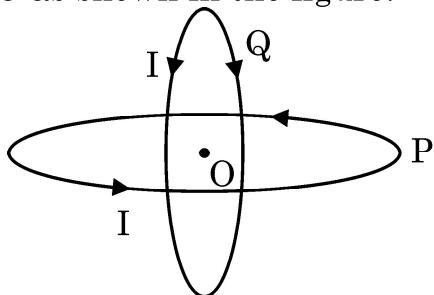
SECTION – B

19. Plot a graph showing the variation of photo electric current, as a function of anode potential for two light beams having the same frequency but different intensities I_1 and I_2 ($I_1 > I_2$). Mention its important features. 2
20. (a) How will the De Broglie wavelength associated with an electron be affected when the (i) velocity of the electron decreases ? and (ii) accelerating potential is increased ? Justify your answer. 2
- OR**
- (b) How would the stopping potential for a given photosensitive surface change if (i) the frequency of the incident radiation were increased ? and (ii) the intensity of incident radiation were decreased ? Justify your answer. 2
21. How are electromagnetic waves produced ? Write their two characteristics. 2
22. Three point charges Q , q and $-q$ are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L as shown in figure. What is 2



- (i) the electrostatic potential energy of the arrangement ? and
(ii) the potential at point D ?

23. (a) Two identical circular loops P and Q, each of radius R carrying current I are kept in perpendicular planes such that they have a common centre O as shown in the figure.



Find the magnitude and direction of the net magnetic field at point O. 2

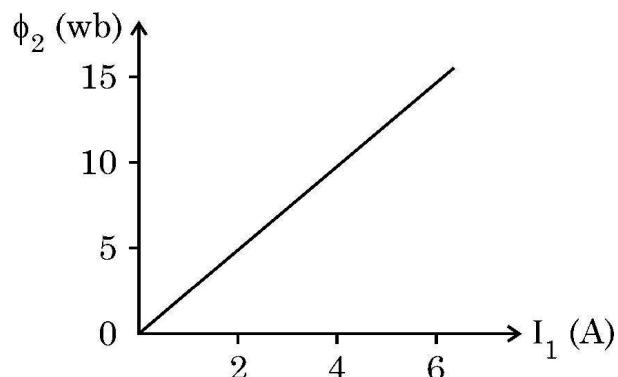
OR



- (b) कोई लम्बा सीधा चालक जिससे $+x$ दिशा के अनुदिश स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है, $X'X$ – अक्ष के अनुदिश रखा है। किसी क्षण t पर द्रव्यमान m और आवेश q का कोई कण बिन्दु (x, y) पर $+y$ दिशा में वेग v से गति करता है। इस चालक के कारण कण पर आरोपित बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। 2

24. समान पदार्थ के बने दो चालकों की लम्बाई समान परन्तु अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल A_1 और A_2 ($A_1 > A_2$) भिन्न है। ये चालक पार्श्व में किसी सेल से संयोजित हैं। यह दर्शाइए कि इन दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग समान है। 2

25. दो कुण्डलियों C_1 और C_2 को एक दूसरे के काफी निकट रखा गया है। आरेख में दर्शाइए अनुसार कुण्डली C_1 में प्रवाहित धारा I_1 के साथ कुण्डली C_2 से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स ϕ_2 विचरण करता है। ज्ञात कीजिए : 2



- (i) इस व्यवस्था का अन्योन्य प्रेरण, और
(ii) C_2 कुण्डली में 100 V का emf प्रेरित करने के लिए धारा परिवर्तन की दर $\left(\frac{dI_1}{dt} \right)$

खण्ड – ग

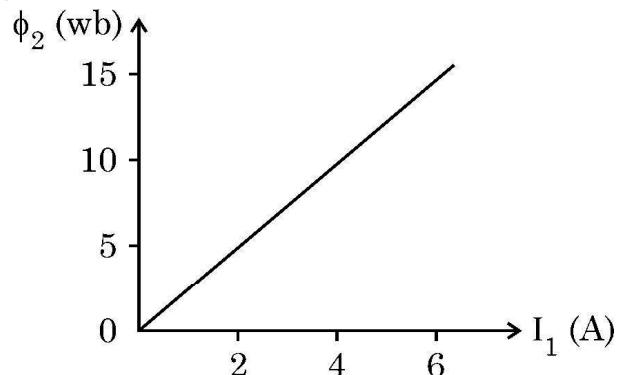
26. (a) अपवर्तनांक ' μ_1 ' के किसी माध्यम में संचरण करता कोई समतल तरंगाग्र किसी समतल पृष्ठ पर आपतन कोण (i) बनाते हुए आपतन करता है। यह μ_2 ($\mu_2 > \mu_1$) अपवर्तनांक के किसी माध्यम में प्रवेश करता है। द्वितीयक तरंगिका की हाइगेन्स रचना का उपयोग करके अपवर्तित तरंगिका खींचिए। इस प्रकार सेल के अपवर्तन के नियम का सत्यापन कीजिए। 3

अथवा

- (b) हाइगेन्स रचना का उपयोग करके यह दर्शाइए कि कोई तरंग किसी पृष्ठ से किस प्रकार परावर्तित होती है। इस प्रकार परावर्तन के नियम का सत्यापन कीजिए। 3



- (b) A long straight conductor kept along X' X axis, carries a steady current I along + x direction. At an instant t, a particle of mass m and charge q at point (x, y) moves with a velocity \vec{v} along + y direction. Find the magnitude and direction of the force on the particle due to the conductor. 2
24. Two conductors, made of the same material have equal lengths but different cross-sectional areas A_1 and A_2 ($A_1 > A_2$). They are connected in parallel across a cell. Show that the drift velocities of electrons in two conductors are equal. 2
25. Two coils C_1 and C_2 are placed close to each other. The magnetic flux ϕ_2 linked with the coil C_2 varies with the current I_1 flowing in coil C_1 , as shown in the figure. Find 2



- (i) the mutual inductance of the arrangement, and
(ii) the rate of change of current $\left(\frac{dI_1}{dt}\right)$ that will induce an emf of 100 V in coil C_2 .

SECTION – C

26. (a) A plane wave-front propagating in a medium of refractive index ' μ_1 ' is incident on a plane surface making an angle of incidence (i). It enters into a medium of refractive index μ_2 ($\mu_2 > \mu_1$).
Use Huygen's construction of secondary wavelets to trace the retracted wave-front. Hence verify Snell's law of refraction. 3

OR

- (b) Using Huygen's construction, show how a plane wave is reflected from a surface. Hence verify the law of reflection. 3



27. कोई प्रत्यावर्ती धारा $I = 14 \sin(100\pi t)$ A किसी 30Ω के प्रतिरोधक और $\left(\frac{2}{5\pi}\right) H$ के प्रेरक के श्रेणी संयोजन से प्रवाहित हो रही है। $\sqrt{2} = 1.4$ लेकर परिकलित कीजिए

- (i) प्रतिरोधक और प्रेरक के सिरों पर बोल्टता-पातों के rms मान, और
- (ii) परिपथ का शक्ति गुणांक

3

28. किसी ac जनित्र की कार्यविधि के मूलभूत सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए। इसकी कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए और प्रेरित emf के तात्क्षणिक मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

3

29. (a) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर की धारा सुग्राहिता में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए।

- (b) कोई गैल्वैनोमीटर I_g धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेपण दर्शाता है। इसे $(0 - V)$ परिसर के बोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध R_1 की तथा $(0 - 2V)$ परिसर के बोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध R_2 की आवश्यकता होती है। इस गैल्वैनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

3

30. (a) किसी α -कण की बंधन ऊर्जा MeV में परिकलित कीजिए। दिया है :

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.007825 \text{ u}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.008665 \text{ u}$$

$$\text{He नाभिक का द्रव्यमान} = 4.002800 \text{ u}$$

$$1 \text{ u} = 931 \text{ MeV/c}^2$$

अथवा

- (b) द्रव्यमान संख्या 240 और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिअॉन 7.6 MeV का कोई भारी नाभिक P दो नाभिकों Q और R में विखण्डित होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 110 और 130 तथा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिअॉन क्रमशः 8.5 MeV और 8.4 MeV हैं। इस विखण्डन में मुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए।

3

खण्ड – घ

31. (a) किसी p-n संधि डायोड के (i) अग्र बायसन और (ii) पश्च बायसन में V-I अभिलाखणिक का अध्ययन करने के लिए परिपथ व्यवस्था आलेखित कीजिए। किसी सिलिकॉन डायोड का प्ररूपी V-I अभिलाखणिक खींचिए। नीचे दिए गए पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए :

5

- (i) अग्र दिशिक बायसन में अल्पसंख्यक (अल्पांश) वाहक अंतःक्षेपण
- (ii) पश्च दिशिक बायसन में भंजन बोल्टता

अथवा



27. An alternating current $I = 14 \sin(100\pi t)$ A passes through a series combination of a resistor of 30Ω and an inductor of $\left(\frac{2}{5\pi}\right) H$. Taking $\sqrt{2} = 1.4$, calculate the
(i) rms value of the voltage drops across the resistor and the inductor,
and
(ii) power factor of the circuit. 3
28. State the basic principle behind the working of an ac generator. Briefly describe its working and obtain the expression for the instantaneous value of emf induced. 3
29. (a) Briefly describe how the current sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased.
(b) A galvanometer shows full scale deflection for current I_g . A resistance R_1 is required to convert it into a voltmeter of range $(0 - V)$ and a resistance R_2 to convert it into a voltmeter of range $(0 - 2V)$. Find the resistance of the galvanometer. 3
30. (a) Calculate the binding energy of an alpha particle in MeV. Given
mass of a proton = 1.007825 u
mass of a neutron = 1.008665 u
mass of He nucleus = 4.002800 u
 $1\text{ u} = 931\text{ MeV}/c^2$ 3
- OR**
- (b) A heavy nucleus P of mass number 240 and binding energy 7.6 MeV per nucleon splits into two nuclei Q and R of mass number 110 and 130 and binding energy per nucleon 8.5 MeV and 8.4 MeV respectively. Calculate the energy released in the fission. 3

SECTION – D

31. (a) Draw the circuit arrangement for studying V-I characteristics of a p-n junction diode in (i) forward biasing and (ii) reverse biasing. Draw the typical V-I characteristics of a silicon diode. Describe briefly the following terms : (i) minority carrier injection in forward biasing and (ii) breakdown voltage in reverse biasing. 5

OR



- (b) p-n संधि डायोड बनने में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण प्रक्रमों के नाम लिखिए। परिपथ आरेख की सहायता से पूर्ण दिष्टकारी के रूप में किसी संधि डायोड की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। इसके निवेशी और निर्गत तरंगरूप खींचिए। किसी संधि डायोड के उस अभिलाक्षणिक गुण का उल्लेख कीजिए जो इसे दिष्टकरण के लिए उपयुक्त बनाता है।

5

32. (a) (i) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। निकट बिन्दु पर अंतिम प्रतिबिम्ब बनने की स्थिति के लिए कुल आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- 3
- (ii) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 1.25 cm फोकस दूरी के अभिदृश्यक से कोई बिम्ब 1.5 cm की दूरी पर स्थित है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है तथा अंतिम प्रतिबिम्ब निकट बिन्दु पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए।
- 2

अथवा

- (b) (i) सामान्य समायोजन में किसी खगोलीय दूरदर्शक द्वारा किसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- (ii) सामान्य समायोजन में किसी खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 2.9 है तथा इसके अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्कन 150 cm है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

5

33. (a) (i) किसी विद्युत क्षेत्र की क्रिया के अधीन नियत ताप पर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार औसत वेग प्राप्त करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- 3

- (ii) किसी बैटरी से श्रेणी में संयोजित ऐसे दो चालक तारों A और B पर विचार कीजिए जिनके व्यास समान हैं परन्तु पदार्थ भिन्न हैं। तार A में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तार B की तुलना में 1.5 गुना है। तार A में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और तार B में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए।
- 2

अथवा

- (b) (i) कोई सेल जिसका emf (E) और आंतरिक प्रतिरोध (r) है किसी परिवर्ती लोड प्रतिरोध (R) के सिरों से संयोजित है। (i) R और (ii) लोड में धारा (I) के साथ टर्मिनल वोल्टता V के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ आलेखित कीजिए।
- 2
- (ii) तीन सेल, जिनमें प्रत्येक का emf E परन्तु आन्तरिक प्रतिरोध $2r$, $3r$ और $6r$ हैं, पार्श्व में किसी प्रतिरोधक R से संयोजित हैं। निम्नलिखित के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए :
- (i) परिपथ में प्रवाहित धारा, और (ii) तुल्य सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवान्तर
- 3



- (b) Name two important processes involved in the formation of a p-n junction diode. With the help of a circuit diagram, explain the working of junction diode as a full wave rectifier. Draw its input and output waveforms. State the characteristic property of a junction diode that makes it suitable for rectification. 5

32. (a) (i) Draw a ray diagram to show the working of a compound microscope. Obtain the expression for the total magnification for the final image to be formed at the near point. 3

- (ii) In a compound microscope an object is placed at a distance of 1.5 cm from the objective of focal length 1.25 cm. If the eye-piece has a focal length of 5 cm and the final image is formed at the near point, find the magnifying power of the microscope. 2

OR

- (b) (i) Draw a ray diagram for the formation of image of an object by an astronomical telescope, in normal adjustment. Obtain the expression for its magnifying power.

- (ii) The magnifying power of an astronomical telescope in normal adjustment is 2.9 and the objective and the eyepiece are separated by a distance of 150 cm. Find the focal lengths of the two lenses. 5

33. (a) (i) Explain how free electrons in a metal at constant temperature attain an average velocity under the action of an electric field. Hence obtain an expression for it. 3

- (ii) Consider two conducting wires A and B of the same diameter but made of different materials joined in series across a battery. The number density of electrons in A is 1.5 times that in B. Find the ratio of drift velocity of electrons in wire A to that in wire B. 2

OR

- (b) (i) A cell emf of (E) and internal resistance (r) is connected across a variable load resistance (R). Draw plots showing the variation of terminal voltage V with (i) R and (ii) the current (I) in the load. 2

- (ii) Three cells, each of emf E but internal resistances $2r$, $3r$ and $6r$ are connected in parallel across a resistor R .

Obtain expressions for (i) current flowing in the circuit, and (ii) the terminal potential difference across the equivalent cell. 3



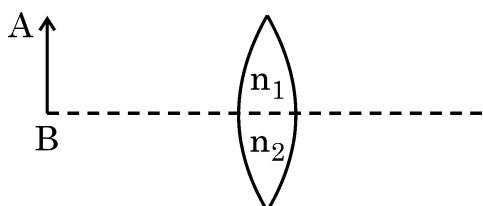
खण्ड – ४

नोट : प्रश्न संख्या 34 और 35 केस आधारित प्रश्न हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

34. कोई लेंस पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम के दो ऐसे पृष्ठों से घिरा होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। किसी एकल गोलीय पृष्ठ द्वारा लेंस के दोनों पृष्ठों पर सफलतापूर्वक प्रतिबिम्ब बनने को ध्यान में रखते हुए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त किया जाता है। यह सूत्र उपयुक्त वक्रता त्रिज्याओं के पृष्ठों के उपयोग से बांधित फोकस दूरी के लेंसों की अभिकल्पना में उपयोगी है। यह सूत्र किसी लेंस के लिए u , v और f के बीच संबंध प्राप्त करने में सहायता करता है। लेंस बिम्बों के प्रतिबिम्ब बनाते हैं और इनका उपयोग बहुत से प्रकाशिक युक्तियों जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक में किया जाता है।

4

- (i) आरेख में दर्शाए अनुसार कोई बिम्ब AB किसी संयुक्त (मिश्र) उत्तल लेंस के सामने स्थित है। क्या इस लेंस द्वारा एक प्रतिबिम्ब बनेगा? यदि नहीं, तो व्याख्या कीजिए।



- (ii) उत्तल लेंस द्वारा बने किसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब का पर्दे पर प्रेक्षण किया गया है। यदि पर्दे को हटा लिया जाए तो क्या फिर भी प्रतिबिम्ब बनेगा? व्याख्या कीजिए।
- (iii) कोई उभयोत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के काँच का बना है और उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो आवश्यक वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (iii) दो उत्तल लेंस A और B जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 15 cm और 10 cm है एक दूसरे से 'd' दूरी पर समाक्ष रखे हैं। लेंस A के सामने 30 cm दूरी पर कोई बिन्दु बिम्ब स्थित है। यदि लेंस B से निर्गत तरंगें मुख्य अक्ष के समान्तर हैं, तो 'd' का मान ज्ञात कीजिए।



SECTION – E

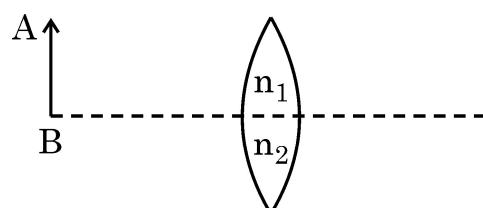
Note : Questions number 34 and 35 are Case Study based questions.

Read the following paragraph and answer the questions.

34. A lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces; at least one of which should be spherical. Considering image formation by a single spherical surface successively at the two surfaces of a lens, lens maker's formula is obtained. It is useful to design lenses of desired focal length using surfaces of suitable radii of curvature. This formula helps us obtain a relation between u , v and f for a lens. Lenses form images of objects and they are used in a number of optical devices, for example microscopes and telescopes.

4

- (i) An object AB is kept in front of a composite convex lens, as shown in figure. Will the lens produce one image ? If not, explain.



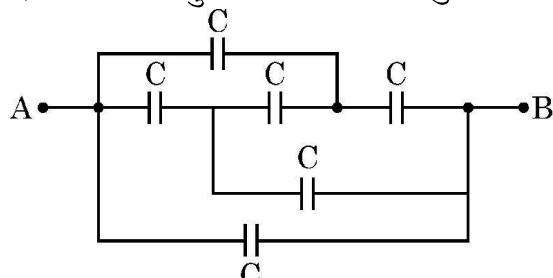
- (ii) A real image of an object formed by a convex lens is observed on a screen. If the screen is removed, will the image still be formed ? Explain.
- (iii) A double convex lens is made of glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. Find the radius of curvature required if focal length is 20 cm.

OR

- (iii) Two convex lenses A and B of focal lengths 15 cm and 10 cm respectively are placed coaxially 'd' distance apart. A point object is kept at a distance of 30 cm in front of lens A. Find the value of 'd' so that the rays emerging from lens B are parallel to its principal axis.



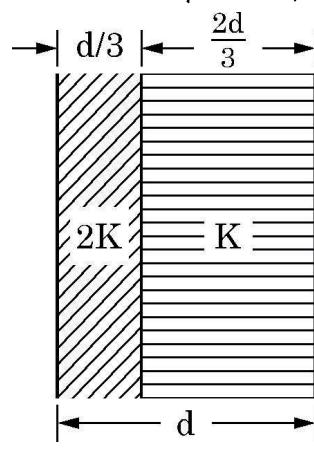
35. कोई संधारित्र ऐसा निकाय होता है जिसमें दो चालक किसी विद्युतरोधी द्वारा पृथकित होते हैं। दोनों चालकों पर परिमाण में समान परन्तु विजातीय आवेश होता है और दोनों चालकों के बीच विभवान्तर होता है। संधारित्र की धारिता निकाय में ज्यामितीय विन्यास (आकृति, आकार और पृथकन) और चालकों को पृथक करने वाले विद्युतरोधी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। संधारित्रों का उपयोग आवेशों को संचित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधकों की भाँति संधारित्रों को भी वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए श्रेणी अथवा पार्श्व अथवा इन दोनों के संयुक्त संयोजन में व्यवस्थित किया जा सकता है।
- 4
- (i) आरेख में दर्शाए गए परिपथ में बिन्दु A और B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए।



- (ii) किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत गुटका (स्लैब) धंसा दिया गया है। इससे पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र घट जाता है। व्याख्या कीजिए।
- (iii) किसी संधारित्र A जिस पर आवेश Q और जिसकी धारिता C है को किसी 2C धारिता के अनावेशित संधारित्र B के सिरों से संयोजित किया गया है। निम्नलिखित के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए :
- संयोजन के सिरों पर विभवान्तर
 - संधारित्र A के आवेश में हानि

अथवा

- (iii) आरेख में दर्शाए अनुसार पट्टिका क्षेत्रफल A और पट्टिका पृथकन d के किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच के स्थान को परावैद्युतांक $2K$ और K के दो गुटकों (स्लैब) से भरा गया है। इस निकाय की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।

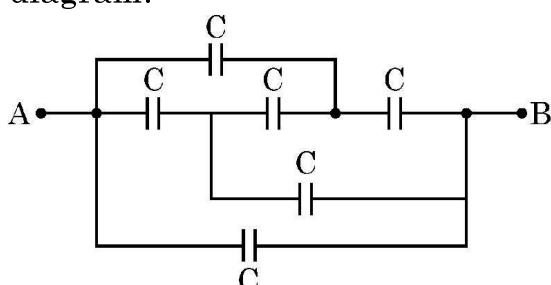




35. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. The two conductors have equal and opposite charges with a potential difference between them. The capacitance of a capacitor depends on the geometrical configuration (shape, size and separation) of the system and also on the nature of the insulator separating the two conductors. They are used to store charges. Like resistors, capacitors can be arranged in series or parallel or a combination of both to obtain desired value of capacitance.

4

- (i) Find the equivalent capacitance between points A and B in the given diagram.



- (ii) A dielectric slab is inserted between the plates of a parallel plate capacitor. The electric field between the plates decreases. Explain.
(iii) A capacitor A of capacitance C, having charge Q is connected across another uncharged capacitor B of capacitance 2C. Find an expression for (a) the potential difference across the combination and (b) the charge lost by capacitor A.

OR

- (iii) Two slabs of dielectric constants $2K$ and K fill the space between the plates of a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation d as shown in figure. Find an expression for capacitance of the system.

